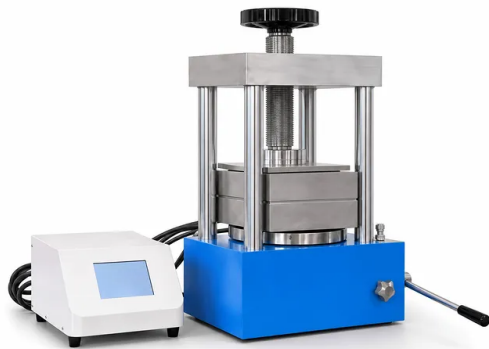


24-Ton-Integrierte Heizpresse 200X200Mm Für Laborprobenvorbereitung

Artikelnummer: XP55



Einführung

Professionelle integrierte Heizpresse mit 24 Tonnen Presskraft und 200x200mm beheizten Platten, ideal für Batterieforschung, Materialprüfung und Probenvorbereitung. Präzise Temperaturregelung bis zu 300°C sorgt für zuverlässige, konsistente Ergebnisse.

[Mehr erfahren](#)

Anwendung	Beschreibung	Hauptvorteil
Batterieelektroden- & -elektrolyt-Pressen	Konsolidierung von Kathoden-/Anodendpulvern und Bildung von Festkörperelektrolyt-Pellets für Lithium-Ionen- und Batteriezellen der nächsten Generation.	Gleichmäßige Dichteverteilung verhindert Hot Spots und sorgt für konsistente Ionenleitfähigkeit über den Pellet hinweg.
Prägen & Laminieren von Polymerfolien	Thermisches Verbinden von mehrschichtigen Polymerfolien, Versiegeln von Mikrofluidik-Chips und Oberflächentexturierung für Lab-on-a-Chip-Geräte.	Präzise Temperatur- und Druckregelung bewahrt empfindliche Nanostrukturen ohne thermische Degradation.
FTIR- & XRF-Pelletvorbereitung	Herstellung transparenter KBr-Pellets für Infrarotspektroskopie und Schmelzperlen für Röntgenfluoreszenzanalyse.	Eliminiert Luftporen und Dickschwankungen und liefert reproduzierbare spektrale Baselines.
Entwicklung von Verbundwerkstoffen	Heißpressen von Metallmatrixverbundwerkstoffen, keramikverstärkten Polymeren und Konsolidierung von Kohlefaser-Prepregs.	Maximiert die Fasernetzung und Hohlraumeliminierung unter kontrollierten Wärme- und Druckprofilen.
Pilotproduktion von Pharmatabletten	Kleinstmengenkompression von Pulvermischungen zu Tabletten für Formulierungsversuche und Stabilitätsstudien.	Volle Datenprotokollierung der Pressparameter unterstützt FDA/EMA-Dokumentation und Skalierungsstudien.
Pulvermetallurgisches Sintern	Vorkompaktion von Metall- und Keramikpulvern bei erhöhten Temperaturen vor dem endgültigen Sintern.	Erhöht die Gründichte und reduziert den Sinterschwund, verbessert die Genauigkeit der Endform.
Halbleiter-Wafer-Bonden	Thermisches Kompressionsbonds von Siliziumwafern oder Chip-on-Flex-Baugruppen unter Verwendung kontrollierter Kraft und Temperatur.	Erzielt gleichmäßige Bondlinien ohne Hohlräume, kritisch für die Herstellung von mikro-elektro-mechanischen Systemen (MEMS).

Parameter	XP55
Modell	XP55
Presskapazität	0 – 24 Tonnen
Platten-Arbeitstemperatur	Umgebung – 300 °C
Heizleistung (Gesamt)	1200 W (2 × 600 W)
Plattenabmessungen	200 × 200 mm
Plattenkühlung	Integrierte Wasserzirkulation
Temperaturregelung	Dual-Zone PID mit ±2 °C Stabilität
Anzeige & Steuerung	4,3-Zoll-Touchscreen, programmierbar
Stromversorgung	220 V, 50 Hz, einphasig
Gesamtabmessungen (B × T × H)	950 × 260 × 525 mm

Parameter	XP55
Nettogewicht	180 kg